

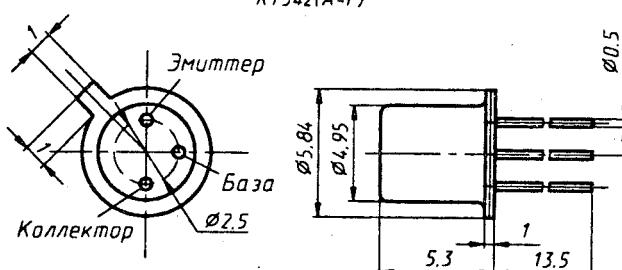
**КТ342А, КТ342Б, КТ342В, КТ342Г,
КТ342АМ, КТ342БМ, КТ342ВМ, КТ342ГМ, КТ342ДМ**

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *p-n-p* универсальные. Предназначены для применения в импульсных устройствах. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами (КТ342А, КТ342Б, КТ342В, КТ342Г) и пластмассовом корпусе с гибкими выводами (КТ342АМ, КТ342БМ, КТ342ВМ, КТ342ГМ, КТ342ДМ). Тип приборов КТ342А—КТ342Г указывается на корпусе. Для транзисторов в пластмассовом корпусе используется условная маркировка: КТ342АМ — прямоугольный треугольник и буква «А», КТ342БМ — треугольник и буква «Б»; КТ342ВМ — треугольник и буква «В»; КТ342ГМ — треугольник и буква «Г»; КТ342ДМ — треугольник и буква «Д». Допускается также маркировка цветным кодом: КТ342АМ — синяя метка на плоской части боковой поверхности корпуса и темно-красная на торце; КТ342БМ — синяя и желтая метки; КТ342ВМ — синяя и темно-зеленая метки.

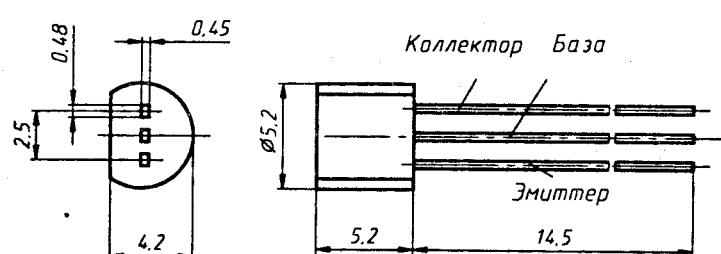
Масса транзистора не более 0,5 г в металлокерамическом корпусе и не более 0,3 г в пластмассовом корпусе.

Изготовитель — акционерное общество открытого типа «Элекс», г. Александров.

КТ342(А-Г)



КТ342(АМ-ДМ)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 5$ В, $I_3 = 1$ мА для КТ342А, КТ342Б, КТ342В, КТ342Г и $I_3 = 2$ мА для КТ342АМ, КТ342БМ, КТ342ВМ, КТ342ГМ, КТ342ДМ:

$T = +25$ °C:

KT342A, KT342AM, KT342ГМ	100...250
KT342Б, KT342БМ, KT342ДМ	200...500
KT342В, KT342ВМ	400...1000
KT342Г	50...125

$T = -60$ °C:

KT342A, KT342AM, KT342ГМ	25...250
KT342Б, KT342БМ, KT342ДМ	50...500
KT342В, KT342ВМ	100...1000

$T = +125$ °C, не менее:

KT342A, KT342AM, KT342ГМ	100
KT342Б, KT342БМ, KT342ДМ	200
KT342В, KT342ВМ	400

Граничная частота коэффициента передачи тока при $U_{KБ} = 10$ В, $I_3 = 5$ мА, не менее:

KT342A, KT342AM	250 МГц
KT342Б, KT342В, KT342Г, KT342БМ, KT342ВМ	300 МГц
KT342ГМ, KT342ДМ	150 МГц

Граничное напряжение¹ при $I_3 = 5$ мА, не менее:

$T \leq +100$ °C:

KT342A, KT342Г, KT342AM, KT342ГМ ..	25 В
KT342Б, KT342БМ, KT342ДМ	20 В
KT342В, KT342ВМ	10 В

$T = +125$ °C:

KT342A, KT342Г, KT342AM, KT342ГМ ..	20 В
KT342Б, KT342БМ, KT342ДМ	15 В
KT342В, KT342ВМ	10 В

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер

при $I_K = 10$ мА, $I_B = 1$ мА, не более

0,1 В

Напряжение насыщения база—эмиттер

при $I_K = 10$ мА, $I_B = 1$ мА, не более

0,9 В

Обратный ток коллектора при $U_{KБ} = U_{KБ, MAX}$,

не более:

$T = +25$ °C	0,05 мкА
$T = +125$ °C для KT342A, KT342Б, KT342В, KT342Г	10 мкА

Обратный ток коллектор—эмиттер

при $U_{KЭ} = U_{KЭ, MAX}$, $R_{B3} = 10$ кОм, не более:

KT342A, KT342Б, KT342В	30 мкА
KT342Г	100 мкА

¹ В диапазоне температур +100...+125 °C значение граничного напряжения снижается линейно.

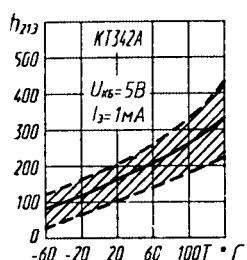
Обратный ток эмиттера при $U_{3B} = 5$ В, не более 30 мкА
 Емкость коллекторного перехода при $U_{kб} = 5$ В,
 не более 8 пФ

Предельные эксплуатационные данные

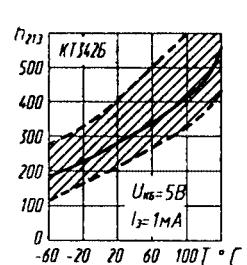
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер ¹ при $R_{бэ} = 10$ кОм:	
$T \leq +100$ °C:	
KT342A, KT342AM, KT342ГМ	30 В
KT342Б, KT342БМ, KT342ДМ	25 В
KT342В, KT342ВМ	10 В
KT342Г	60 В
$T \leq +125$ °C:	
KT342A, KT342AM, KT342ГМ	25 В
KT342Б, KT342БМ, KT342ДМ	20 В
KT342В, KT342ВМ	10 В
KT342Г	45 В
Постоянное напряжение эмиттер—база	5 В
Постоянный ток коллектора	50 мА
Импульсный ток коллектора при $t_i \leq 40$ мкс, $Q \geq 500$	300 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллек- тора ² :	
при $T \leq +25$ °C	250 мВт
при $T = +125$ °C	50 мВт
Температура $p-n$ перехода	+150 °C
Температура окружающей среды	-60...+125 °C

¹ В диапазоне температур +100...+125 °C значение максимально допустимо-
го напряжения коллектор—эмиттер снижается линейно.

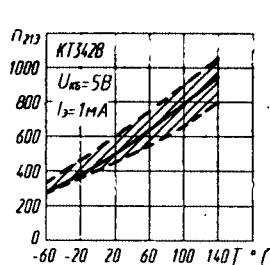
² В диапазоне температур +25...+125 °C допустимое значение рассеиваемой
мощности снижается линейно.



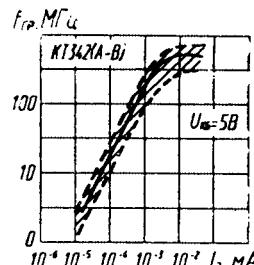
Зона возможных положений зависимости
статического коэффициента передачи тока
от температуры



Зона возможных поло-
жений зависимости ста-
тического коэффициен-
та передачи тока
от температуры



Зона возможных поло-
жений зависимости ста-
тического коэффициен-
та передачи тока
от температуры



Зона возможных поло-
жений зависимости гра-
ничной частоты от тока
эмиттера